## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-214123

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月19日

G 02 F H 01 S H 04 B

7246-2H 6940-5F

8523-5K H 04 B Z

審査請求 有

請求項の数 4 (全9頁)

光ソリトン発生方法およびソリトン伝送方法 60発明の名称

> 頭 平2-9546 ②特

頤 平2(1990)1月19日 ❷出

明 者 ф 沢

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式 Œ

会社内

明 者 和 宣 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

@発

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

の出 願 日本電信電話株式会社

郎

弁理士 志賀 正武 個代 理 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

#### 1. 発明の名称

個発

光ソリトン発生方法およびソリトン伝送方法 2. 特許請求の範囲

(1) 半導体レーザに供給する電流の値を正弦的 もしくはパルス的に変化させることにより発生す る光パルスを掛岐制限した狭裕岐光フィルターを 通過させてパルス幅とそのスペクトル幅との役が 0.32~0.44となる光パルスに変換し、次い で、技光パルスをエルビウムファイバー増幅器を 用いて光幅し、そのピーク出力Pが

$$P = 0.776 \times \frac{\lambda^{2}}{\pi^{2} n_{1} C} \times \frac{|D|}{\tau^{2}} \times Aeff$$

(n.:非線形組折率、入:光パルスの波及、τ;光パ ルスの半債金幅、 | D | : 光ソリトンを伝搬させ る光ファイバの群速度分散、Aeff:光ソリトンを 伝掘させるファイバの有効断面積、 C:光速)で与 えられる光ソリトンパルス列を得ることを特徴と する光ソリトン発生方法。

- (2) 前紀狭街域光フィルターと前記エルビウム ファイバー増幅器との間に時分割多重用の1:1 分岐比の3dB光結合器を複数個連続して結合し、 時間種延を与えらることにより、 2 \* \* ' 倍の光ソ リトンパルス列を得ることを特徴とする請求項! 紀載の光ソリトン発生方法。
- (3) 前紀半導体レーザに供給する電流を正弦的 もしくはパルス的に変化させる代りに、コード化 されたパルス信号を直接供給することにより、コ - ド化された光ソリトンパルス列を請求項 1 記載 の光ソリトン発生方法により発生させ、その発生 した光ソリトンパルス列を長尺の単一モードファ イバを通過させ、さらに高速の光検出器により検 山することにより光面信を行なうことを特徴とす るソリトン伝送方法。
- (4) 請求項1記載の光ソリトン発生方法により 羽られた光ソリトンパルス列をLiNbО。6しく は M Q W (多 重 量 子 井 戸 構 造 ) 半 導 体 を 用 い た 吸 収 型の光強度変調器によりコード化し、このコード 化した光ソリトンパルス列を長尺の単一モードファ

#### 特開平3-214123 (2)

イバを通過させ、さらに高速の光検出器により検 出することにより光通信を行なうことを特徴とす るソリトン伝送方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 「 産業上の利用分野 」

本発明は半導体レーザからの光パルス発生において、従来発生が不可能であった光ソリトンパルスを簡単な干渉計によりフィルタリングすることにより発生させるとともに、光ファイバー内を伝搬させるソリトン発生方法およびソリトン伝送方法に関する。

#### 「従来の技術」

① 菜9図はカラーセンターレーザーによる光ソリトン発生方法を説明するための図である。この図において、「はモード同期YAGレーザで励起された波及「、5μ m帯の光パルスを発生するカラーセンターレーザー、2、2は各々結合レンズ、3はソリトン伝送用ファイバー(単一モードファイバー)、4は先検出器である。

カラーセンターレーザーから発生する光パルス

れる。また、同図(ハ)に示すように、ピークパワーアが1.2 Wの場合には、出力パルスの故形が人力光パルスと同一になっていることがわかる。すなわち、このソリトン伝送用ファイパー 3 では、ピークパワーア = 1.2 Wにて N = 1 ソリトンが助版されることがわかる。一方、同図(二).(ホ)に示すように、ピークパワーアを 5 ~ 1 1.4 Wと増加させた場合には、高次ソリトンが励扱されている様子がよくわかる。

② 次に、第11図は正弦波変調による短パルスの発生方法を説明するための図である。この図において、5は正弦波発生器、6は電気増幅器、7は半導体レーザである。なお、結合レンズ2およびソリトン伝送用ファイバー3は上記構成のものと同一である。

この方法では、半導体レーザ7を正弦波変調することにより、パルス列を高繰り返しで発生させて、ソリトン伝送用ファイバー3に導びくようにしている。

② 次に、第12図はコムジェネレータによる短

は、そのパルス幅が約10ps程度であり、ピークパリーが100Wにも達するため、容易にソリトン伝送用ファイバー3内に数10Wのパルスパワーのものを励起できる。N=1で表わされる選本光ソリトンの故形はSech(t)の形をしているが、カラーセンターレーザーからの出力故形も、ほぼSech(t)で表わされるため、容易に光ソリトンパルスが発生する。なお、先ソリトンに関しては、中沢正陸 \*光ファイバー中の非線形光学\* 必用物理 第56巻、第10号、P・1265~P・1288(1987)もしくは \*光パルスの圧縮とソリトンレーザ\* レーザ研究、解説、第15巻11号P・869-886頁(1987)を参考。

この方法により得られる光ソリトンの破形の変化を第10図に示す。この場合、ソリトン伝送用ファイバー3の長さが700mである。また、人力光パルスは第10図(イ)に示すようになっている。まず、同図(ロ)に示すように、ピークパワーPが0.3wの場合には、明らかに入力光パルスに対して出力パルスのパルス幅の広がりが観測さ

パルスの発生方法を説明するための図であり、この図に示すように、選気増幅器もと半導体レーザイとの間にコムジェネレータ8が挿入されている。このコムジェネレータ8により電気パルスにて半導体レーザ7を駆動し、光パルスを数GHzの高録り返しで発生させる。

④ 次に、第13図は光変調器によるバルスの発生方法を説明するための図である。この図に示すように、半専体レーザ7を直流電額9で駆動してCW光を取り出し、この取り出したCW光を、LiNbO,6しくはMQW(多層量子井戸構造)半導体のシュタルク効果を用いた超高速光変調器10によって変調する。これにより、5~10GH2の繰り返しのバルス列が得られる。

#### 「 雅明が解決しようとする課題 」

ところで、上述した従来の各方法のうち、①項の方法にあっては、光ソリトンの発生にカラーセンターレーザーIを用いるが、その繰り返しがI
00MHz程度と低いことと、大型で高価であることから実用的な立場から難しいという問題があ

#### 特開平3-214123 (3)

る。

また、②および③項の方法にあっては、いずれし埋想的なトランスフォームリミットなパルスが 例られない。 すなわち、10~30m 程度のパルスが発生できるものの、スペクトル幅が大きととの がるので、 パルス 幅 Δ τ と スペクトル幅 Δ レ Δ τ = 1 ~3 程度と なる。このことは、トランスフォームリミット なパルスの条件である Δ ν Δ τ = 0 .3 2 ~ 0 .4 4 からはかなり外れるので、 及 距離に 亘って ソリトン 伝 送用ファイバー3 ので、 及 距離に 豆って ソリトン 伝 送用ファイバー3 の 呼速度分散によって 広がって しまい、 情報が伝えられないという大きな問題がある。

また、①項の方法にあっては、パルス幅が L O O psと広くソリトンとしての利点がない。

本発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、 上述した各問題点を解決することができる光ソリ トンの発生方法およびソリトン伝送方法を提供す ることを目的としている。

「課題を解決するための手段 」

以下、図面を参照して本発明の実施例について 逆明する。

上記情成において、まず、バルス信号発生器 I Iからパルス信号が出力されると、 電気ローパスフィルター I 2 によってその基本波成分のみが取 本発明は、半導体レーザの直接変調によって得られる高繰り返しのパルス列をファブリベローもしくはマッハツェンダ干渉形フィルターを超過させることによりトランスフォームリミットなパルスに変換し、それをエルビウムファイバ増幅器によってこのパルス列を増幅し、光ソリトンを得る。そして、得られたソリトンに送を行う。

「作用」

半切体レーザの直接変調によって高くり返しパルス列が得られる。そして、得られたパルス列のスペクトルが制御され、パルス幅ΔτとそのスペクトルΔνとの質がΔτΔν=0.32~0.44 となるトランスフォームリミットなパルス化が行なわれる。そして、それをさらに光増幅することによって、超高機り返しソリトンパルス列が得られる。次いで、得られたソリトンにルス列を直接変調することによって、ソリトン伝送が行なわれる。

**「実施例」** 

り出される。そして、その基本故成分が電気増幅 26 6 によって増幅され、半導体レーザ駆動用バル スとして、半導体レーザ?に供給される。これに より、半導体レーザ?が駆動する。ここで、半導 体レーザ?に供給される半導体レーザ駆動用バル スの生成される様子を第2図に示す。同図(イ)は バルス信号発生器11の出力放彩を示し、同図(ロ)は で、、同図(ハ)は電気増幅器6の出力放影を示す。 一方、第3図に半導体レーザ?の出力を示す。 図(イ)はそのスペクトルを示し、同図(ロ)はバル スの時間波彩を示す。これら図(イ)、(ロ)に示す ように、実験ではバルス幅がΔλ=1、5 na、時 問幅がΔr=24psが作られている。

ところで、単導体レーザ?へ電子を注入を行なうと配折率が下がるので、レーザの発展周波数は第4図に示すように、一度、長波艮側にチャーブしてもとに戻る(これを負またはダウムチャーブと呼ぶ)。なお、トランスフォームリミットなパルスとは、パルスのフーリェ変換によって得られ

#### 特開平3-214123 (4)

る幅だけのスペクトルを有するパルスのことであり、余分なスペクトルを含まないパルスのことである。

一般に、半導体レーザでは波形がガウス形であ り、スペクトル幅Δνとバルス幅Δτの間には、

$$\Delta \nu \Delta \tau = \frac{\Delta \lambda C}{\lambda^2} \times \Delta \tau = 0.44 \cdots \cdots \oplus$$

の関係がある。第3図で得られたパルスのΔν· Δι特を計算すると、

$$\Delta \nu \Delta \tau = \frac{1.5 \times 10^{-9} \times 340^{9}}{(1.54 \times 10^{-8})^{3}} \times 24 \times 10^{-13}$$

となり、①式の結果と比べると約 1 0 倍の大きさをもっていることがわかる。従って、直接変調によって得られるパルスはトランスフォームリミットからは程度い。これが半導体レーザの直接変調のもつ木質的な欠点である。

本発明では、この半導体レーザのチャーブ特性 に着目し、ファブリベロー干渉計 I 3 を用いてスペクトルをトランスフォームリミット化する。この場合、実験ではファブリベロー干渉計 I 3 の透

人すると、トランスフォームリミットなパルスが 得られる。しかし、このままでは、透過出力が約 5~10dB低下じてしまう。この原因としては、 一つ目には、スペクトル幅を制限することによる 損失、2つ目には、ファブリペロー干渉計13の 透過損失があるからである。実験においてはファ ブリペロー干渉計13のフリースペクトルレンジ が約6nmになるように設定した。すなわち、フリースペクトルレンジをΔλとすると、

$$\Delta \lambda = \frac{C}{2L} \times (\frac{\lambda^{*}}{C})$$
$$= \frac{(1.54 \times 10^{-9})^{*}}{2 \times 200 \times 10^{-9}}$$

である。従って、Distributed Feedback Laser (DFB) の場合、単一スペクトル発展 (チャープは合む)であり、その幅は広くとも 2 ne程度であるから、 6 naのフィルター間隔があれば充分である。すなわち、他のフィルター成分が入ってこない。ファブリペロー干渉計!3の帯域に関しては、ファ

 $\Delta \ \nu \ \Delta \ \tau = \frac{0.22 \times 10^{-9} \times 3 \times 10^{-9}}{(1.54 \times 10^{-9})^2} \times 17 \times 10^{-12}$ 

となり、この値は①式の結果に非常に近く、トランスフォームリミットなパルスが得られていることを示している。もともとチャーブパルスであるから 0.22nmの幅でも原理的には僅かなチャーブがあるが、このチャーブを完全に結(するにはファブリペロー干渉計13と光カップラー14との間に負のチャーブが存在すると、10ps/nmであるが、これは零分散改長を1.6~1.8μm帯にシフトしたファイバーの分散量が50ps/km/mmであることを用いて、本緒仮用の光ファイバーの及さを200mにすると良い。

このようにしてファブリペロー干渉計13を挿

ブリベロー干渉計 1 3 を構成する鉄の反射率を透 当に設定することによりフィネスを、 0 . 1 ~ 1 n m程度の併域に顕璧すればよい。

以上のようにすることによって、パルス出力は 弱いが完全にトランスフォームリミットなパルス 列ができる。

次に、これらをソリトンパルス列のパワーレベルまで光増幅する。それをエルビウムファイパー 増幅器 (光カップラー 14、エルビウム励起用光 源 15 およびエルビウムファイバー 16 の 和 み 合わせ)により行う。ここで、N=1 の 標準ソリトンのパルスピークパワーを  $P_{N-1}$  とすると  $P_{N-1}$  は  $P_{N-1}=0.776$   $\frac{\lambda^2}{\pi^2 \ln C}$  ×  $\frac{1}{\pi^2}$   $\frac{1}{\pi^2}$  A eff

この場合、 n t は非線形屈折率、 A は光パルスの故 良、 r は光パルスの半値全幅、 I D I はソリトン 伝送用ファイバー 3 の群速度分散、 A effはソリ トン伝送用ファイバー 3 の有効断面積、 C 光速で ある。

#### 特開平3-214123 (5)

ファブリペロー干渉計13の出力としてはビークパワーが1aW程度である。ソリトンを伝送するソリトン伝送用ファイバー3の規格としては、例えば1Dl=3ps/ka・naの分散シフトファイバーを用い、Aeff=4×10°ca\*に設定できるため、人力で「20psのパルスであると、シリカ系ファイバーのn,がn。\*\*\*で与えられることを考慮すると、『w・・は

$$P_{N+1} = 0.776 \frac{(1.55 \times 10^{-4})^{2}}{(\pi)^{2} \times 3.2 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-4}} \cdot \frac{3 \times 10^{-6}}{(20 \times 10^{-7})^{2}}$$

x4x10-''=9.2 aW ……⑤ となる。すなわち、上記のパワーがあればN=I のSech形ソリトンが及尺のソリトン伝送用ファイパー3を伝数することができる。

次に、必要なエルビウムファイバー増幅器の利 役は式動と、人力!mWの条件より10dB程度で よいことになる。この場合、第5図に示すように、 20dB以上の利得が3~100m程度のエルビウ ムファイバーにおいて容易に得られるため、本方 法は非常に有効なことがわかる。なお、本増幅の

このようにして得られたパルスはソリトンとしてソリトン伝送用ファイバー3を伝搬した後、プリエンファシス法(特願平1-68619 光ソリトン伝送方式、久保田寛和、中沢正隆、鈴木和立)により再生中観された後、最終的に光検出器
4で情報が取り出され、ソリトンによる光通信が 記了する。

ここで、時間遅延を発生させバルスの多重化を 図るために接続した 3 d B カップラーの 2 つの筋 詳細については中沢正陈、光学、18色6号P. 291~P. 296 \*光ファイバーによる光増額 ・を参考。

ここで、信号光以外の自然放出光による雑音は 自然放出光除去用光フィルター 1 7 で除去される。 また、その他の雑音として非ソリトン的な成分が ソリトン伝送用ファイバー 3 に損失があるため 他 かに発生する。しかし、これも過飽和吸収体、例 えば 1 n G a A s 系の M Q W 半導体を自然放出光節 去用フィルター 1 7 に付加することにより、ソリトン部分は完全に透過し、非ソリトン部分は完全に透過し、非ソリトンを伝送することができる。その様子を第 5 図に示す。同図(イ)は過飽和吸収体 透過前、同図(ロ)は通過後で完全に推音が除去できていることがわかる。

次に、第8図は本発明の第3実施例を説明するための図であり、第7図と同様に半導体レーザ7を直接変調する代りにしiNbO。光変調器もしくはMQWの半導体を用いた吸収型光変調器もしるをファブリベロー干渉計13と光カップラー14との間を挿入し、これにより光ソリトンのON・OPFを行なう。本方法は吸収型光変調器10a

#### 特開平3-214123 (6)

を用いる必要があるが、半導体レーザ 7 を直接変調する必要がないという利点がある。

#### 「 発明の 効果 」

以上説明してきたように、従来、不可能とされてきた半導体レーザからトランスフォームリミットな高出力ソリトンパルスの発生をファブリペロー干渉計等の狭帯域フィルターとエルビウムファイパー増幅器を用いる通信に幅広く通用するで、光の強度変調を用いる通信に幅広く通用することができるという利点がある。すなわち、従来、高速の光通信には不可欠であったしiNbO。もしくはMQWの半導体による高速光調器が不必要になり、単に半導体レーザを高速に直接変調すればよい。したかって、光ソリトン伝送システムが非常に簡便なものとなる利点がある。

もしも仮に、パルスコードで半導体レーザを直接変調した場合にパルス波形が乱れるならば、高速光変調器を挟帯域フィルターとエルビウムファイパー増幅器との間に挿入すればよい。この場合、半導体レーザを直接変調しないので、より安定な

第11回は正弦波変調による短パルス発生方法を 説明するための図、第12回はコムジェネレータ による短パルス発生法を説明するための図、第1 3回は光変調器によるパルスの発生方法を説明す るための図である。

- 1 … … カラーセンターレーザー、
- 2 ……結合レンズ、
- 3 … … ソリトン伝送用ファイバ、
- 4 … … 光 検 出 器 、 5 … … 正 弦 波 発 生 器 、
- 6……電気増幅器、7……半導体レーザ、
- 8 … … コムジェネレータ、
- 9 …… 直流電源、10 … … 超高速光変調器、
- 10a……吸収型光変調器、
- 11……パルス信号発生器、
- 12……電気ローパスフィルター、
- 13……挟帯域光フィルター
- (ファブリベロー干渉計など) 、
- 14……光カップラー、
- | 5 … … エルビウム励起用光源、

ソリトン伝送が可能となる可能性がある。

また、本方法は、例える0~100G H z程の 超高速報り返しになっても、半導体レーザの直接 変調がその周波数帯において可能な限り、トラン スフォームリミットなソリトンパルスが実現でき るので、大変有効である。

#### 4. 図面の簡単な説明

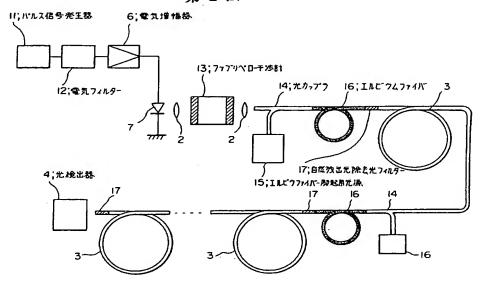
第1 図は本発明の第1 実施例を説明するための図、第2 図は半導体レーザ(7)を駆動するための回路とその各部の出力を示す波形図、第4 図は半レーザ(7)のサーーブ特性を示す図、第5 図ははレーザ(7)のチャーブ特性を示す図、第5 図ははレーザ(7)のチャーブ特性を示す図、第5 図ははひのから 2 実ははが 2 が 3 次の図、第7 図は本発明の第2 実施例の図、第7 図は本発明の第2 実施の図、第9 図はカラーを説明するための図、第9 図はカラーを説明するための図、第1 0 図は第9 図に示す構成にののとしているによるソリトンの波形変化を説明するための図、第1 0 図は第9 図に示す構成にの図、第1 0 図は第9 図に示す構成にのの

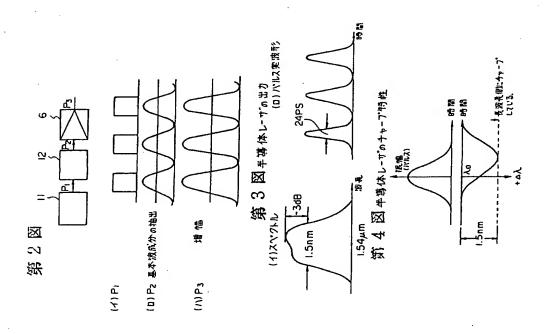
- 16……エルビウムファイバー、
- 」 7 …… 自然放出光除去用光フィルター、
- .1 8 ··· ·· 3 dBカップラー群。

出願人 日本電信電話株式会社 代理人弁理士 志賀正本(第12)

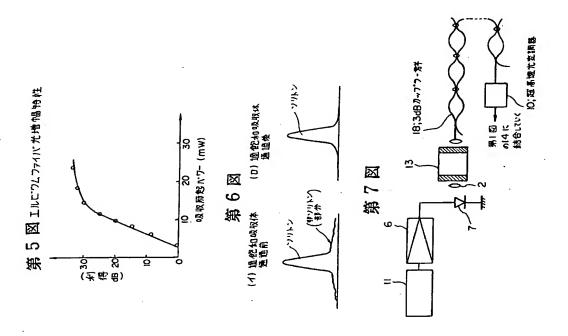
## 特開平 3-214123 (フ)

第1図



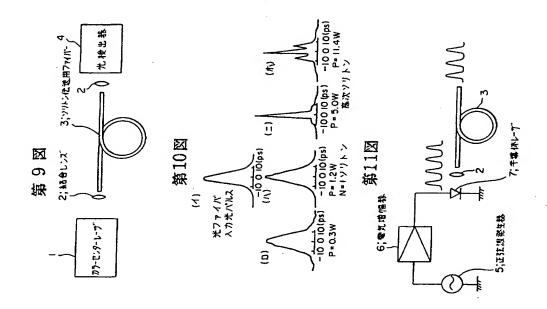


## 特閒平3-214123 (8)

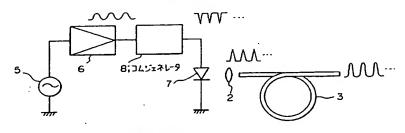


第8図
100;吸収型光复調数
15
15
16

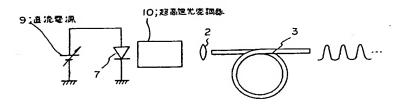
## 特開平3-214123 (9)



## 第12図



第13図



- -(11) Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 3-214123
- (43) Publication Date: September 19, 1991
- (21) Application No. 2-9546
- (22) Application Date: January 19, 1990
- (72) Inventors: NAKAZAWA et al.
- (71) Applicant: Nippon Telegraph and Telephone Corporation
- (74) Agent: Patent Attorney, Masatake SHIGA

#### **SPECIFICATION**

- 1. Title of the Invention: PHOTOSOLITON GENERATING METHOD

  AND SOLITON TRANSMITTING METHOD
- 2. Claims
- (1) A photosoliton generating method wherein the optical pulses generated by sinusoidally or impulsively changing the values of the current supplied to the semi-conductor laser are passed through a narrow-band optical filter of bandwidth limitation into the optical pulses so that the product of the pulse width and the spectral width is 0.32 to 0.44, the optical pulses are amplified by using an erbium fiber amplifier, and the photosoliton pulse train is obtained in which the peak output P is obtained by the formula P = 0.776  $\times \lambda^2/\pi^2 n_2 C \times |D|/\tau^2 \times Aeff$  (where,  $n_2$ ; the non-linear

refractive index,  $\lambda$ ; the wavelength of the optical pulses,  $\tau$ ; the full width half maximum of the optical pulses, |D|; the speed dispersion of the optical fiber to propagate photosolitons, Aeff; the effective sectional area of the fiber to propagate photosolitons, and C; light velocity).

- (2) A photosoliton generating method according to Claim 1, wherein a plurality of 3 dB optical couplers of the 1:1 branching ratio for time-sharing are continuously integrated with each other between the narrow-band optical filter and the erbium fiber amplifier, and the time delay is provided to obtain the double photosoliton pulse train.
- (3) A photosoliton transmitting method to perform optical communication by generating the coded photosoliton pulse train by the photosoliton generating method according to Claim 1 instead of sinusoidally or impulsively changing the current supplied to the semi-conductor laser, allowing the generated photosoliton pulse train to be passed through a long single mode fiber, and detecting the generated photosoliton pulse train by a high-speed photo-detector.
- (4) A photosoliton transmitting method to perform optical communication by cording the photosoliton pulse train obtained by the photosoliton generating method according to

Claim 1 by an absorption type optical intensity modulator using a LiNbO<sub>3</sub> or MQW (Multiple Quantum Well structure) semiconductor, allowing the coded photosoliton pulse train to pass through a long single mode fiber, and detecting the photosoliton pulse train by a high-speed photo-detector.

3. Detailed Description of the Invention

[Technical Field of the Invention] The present invention

relates to a photosoliton generating method and a

photosoliton transmitting method in which photosoliton

pulses which have not been able to generated are generated

by the filtering by a simple interferometer, and propagated

within optical fibers when generating optical pulses from a

semi-conductor laser.

[Description of the Related Art]

(1) Fig. 9 explains a photosoliton generating method by a color center laser. In this figure, reference numeral denotes a color center laser to generate optical pulses of a zone of the wavelength of 1.5 µm excited by the mode-locking YAG laser, reference numerals 2 and 2 denote coupling lenses, reference numeral 3 denotes a photosoliton transmission fiber (a single mode fiber), and reference numeral 4 denotes a photo-detection unit.

The pulse width of the optical pulses generated from the color center laser 1 is about 10 pg, and the peak power

thereof reaches as high as 100W, and the pulse power as high as several 10W can be easily excited within the photosoliton transmission fiber 3. The waveform of the fundamental photosoliton expressed by N = 1 has the form of Sech  $(\tau)$ , and because the output waveform from the color center laser 1 is also expressed substantially by Sech  $(\tau)$ , photosoliton pulses can be easily generated. As for photosoliton, refer to the paper "non-linear optics in optical fibers" by NAKAZAWA, Masataka, Ouyo Butsuri, Vol. 56, No. 10, P. 1265 to P.1288 (1987), or "Compression of optical pulses and photosoliton laser", Reiza Kenkyu, Explanation, Vol. 15, No. 11, P. 869-886 (1987).

Fig. 10 shows the change in the waveform of photosoliton obtained by this method. In this condition, the length of the photosoliton transmission fiber 3 is 700 m. Further, the input optical pulses are shown in Fig. 10 (a). Firstly, as shown in Fig. 10(b), if the peak power P is 0.3W, extension of the pulse width of the output pulse is clearly shown to the optical pulses. As shown in Fig. 10(c), IF the peak power P is 1.2W, it is understood that the waveform of the output pulse is the same as that of the optical pulses. In other words, in this photosoliton transmission fiber 3, it is shown that N = 1 photosoliton is excited at the peak power P = 1.2W. On the other hand, as shown in Fig. 10 (d) and (e), if the peak power P is increased to 5 to 11.4W, it

is clearly shown how high-order photosoliton is excited.

(2) Next, Fig. 11 explains a method for generating short pulses by the sinusoidal modulation. In this figure, reference numeral 5 denotes a method for generating short pulses by sinusoidal modulation. In this figure, reference numeral 5 denotes a sinusoidal generator, reference numeral 6 denotes an electric amplifier, and a reference numeral 7 denotes a semi-conductor laser. The coupling lens 2 and the photosoliton transmission fiber 3 are the same as those in the above configuration.

In this method, the pulse train is generated in a highly repeated manner by performing sinusoidal modulation of the semi-conductor laser 7, and led to the photosoliton transmission fiber 3.

- (3) Next, Fig. 12 explains a method for generating short pulses by a comb-generator. As shown in the figure, the comb-generator 8 is inserted between the electric amplifier 6 and the semi-conductor laser 7. The semi-conductor laser 7 is driven by this comb-generator 8 using electric pulses, and the optical pulses are generated in a highly repeated manner.
- (4) Next, Fig. 18 explains a method for generating pulses by an optical modulator. As shown in this figure, CW light is taken out by driving the semi-conductor laser 7 by a DC power source 9, and the taken-out CW light is modulated by

the super high-speed optical modulator 10 using the Stark effect of a LiNbO<sub>3</sub> or MQW (Multiple Quantum Well structure) semi-conductor. The repetitive pulse train of 5-10 GHz is obtained thereby.

[Problems to be Solved by the Invention]

When applying the method in (1) among the above-described known methods, the color center laser 1 is used for generating photosoliton, raising a problem in that this method is difficult from the practical standpoint because the repetition is as low as about 100 MHz and the color center laser is large and expensive.

Further, in the methods (2) and (3), no pulse of idealistic transform limit can be obtained. In other words, the spectral width is expanded widely though the pulses of about 10 to 30 ps can be generated, and the product of the pulse width  $\Delta \tau$  and the spectral width  $\Delta v$  becomes  $\Delta \tau m \Delta v =$  about 1 to 3. This value is considerably separate from the condition of the pulses of the transform limit that  $\Delta \tau m \Delta v =$  0.32 to 0.44, raising a problem that the pulse is extended by the group velocity dispersion of the fiber 3 if the pulses are propagated in the photosoliton transmission fiber 3 over the long distance, and information cannot be transmitted.

Further, in the method (4), the pulse width is as extensive as 100 ps, realizing no advantages as the

photosoliton.

[Operation]

The present invention has been achieved in light of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a photosoliton generating method and a photosoliton transmitting method capable of solving the above-described problems.

## [Means for Solving the Problems]

In the present invention, the highly repetitive pulse train obtained by direct modulation of the semi-conductor laser is converted into the pulses of the transform limit by being passed through a Fabry-Perot or Mach-Zender interference filter, and the pulse train is amplified by the erbium fiber amplifier to obtain photosoliton. photosoliton transmission is performed by direct modulation of the obtained photosoliton pulse train.

# The highly repetitive pulse train is obtained by direct

modulation of the semi-conductor laser. The spectrum of the obtained pulse train is controlled, performing pulsation of the transform limit under the condition that the product of the pulse width  $\Delta \tau$  and the spectrum  $\Delta v$ ,  $\Delta v \Delta \tau = 0.32$  to 0.44. By performing further optical amplification thereof, the super highly repetitive photosoliton pulse train is obtained. Next, photosoliton transmission is performed by direct modulation of the obtained photosoliton pulse train.

### [Embodiments]

The embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

Fig. 1 explains a first embodiment of the present invention. The components shown in this figure which are identical to or correspond to those in Figs. 9, 11 and 12 are represented by the same reference numerals, and a detailed description thereof is omitted. In this figure, reference numeral 11 denotes a pulse signal generator, reference numeral 12 denotes an electric low-pass filter to allow only the fundamental wave elements of the pulse signal generator 11, reference numeral 13 denotes a narrow-band optical filter (for example, a Fabry-Perot interferometer and a Mach-Zender interferometer, and the Fabry-Perot interferometer is used in the present embodiment), reference numeral 14 denotes an optical coupler to agree the semiconductor laser beam with the optical signal output from the erbium excitation light source 15, reference numeral 16 denotes the erbium fiber, and reference numeral 17 denotes an optical filter for eliminating amplified spontaneous emission which eliminates amplified spontaneous emission other than the optical pulses of the signals.

In the above-described configuration, firstly, when the pulse signal is output from the pulse signal generator 11, only the fundamental wave elements are taken out by the

electric low-pass filter 12. The fundamental wave elements are amplified by the electric amplifier 6, and supplied to the semi-conductor laser 7 as the semi-conductor laser driving pulse. The semi-conductor laser 7 is driven thereby. Here, Fig. 2 shows how the semi-conductor laser driving pulse to be supplied to the semi-conductor laser 7 is generated. Fig. 2 (a) shows the output waveform of the pulse signal generator 11, and Fig. 2(b) shows the output waveform of the electric low-pass filter 12. Fig. 2(c) shows the output waveform of the electric amplifier 6. On the other hand, Fig. 3 shows the output of the semiconductor laser 7. Fig. 3(a) shows the spectrum thereof, and Fig. 3(b) shows the time waveform of the pulse. As shown in Figs. 3(a) and (b), the pulse width of  $\Delta\lambda = 1.55$  mm, and the time width of  $\Delta \tau = 24$  ps are obtained in the experiment.

When electrons are injected in the semi-conductor laser 7, the refractive index is reduced, and the laser beam oscillation frequency is once chirped to the long wavelength side once, and returned to the original as shown in Fig. 4 (this is referred to as the negative chirp or the daumchirp). The pulse of the transform limit means the pulse having the spectrum of only the width obtained by Fourier transformation of the pulse, which includes no surplus spectrum.

Generally speaking, the waveform of the semi-conductor laser is Gauss type, and there is a following relationship between the spectral width  $\Delta v$  and the pulse width  $\Delta \tau$ .

$$\Delta v \Delta \tau = \Delta \lambda C / \lambda 2 \times \Delta \tau = 0.44 \tag{1}$$

The product  $\Delta v \Delta \tau$  of the pulse obtained in Fig. 3 is calculated as follows:

 $\Delta v \Delta \tau = 1.5 \times 10^{-2} \times 340^{2} / (1.54 \times 10^{-2})^{2} \times 24 \times 10^{-12} = 4.6$ (2)

Comparison with the result of the formula (1) shows that the product is about 10 times larger than the result. Therefore, the pulse obtained by direct modulation is far from the transform limit. This is the essential disadvantage of direct modulation of the semi-conductor laser.

In the present invention, attention is paid to the chirp characteristic of this semi-conductor laser, and the spectrum is turned into the transform limit by using the Fabry-Perot interferometer 13. In this case, the transmission band zone of the Fabry-Perot interferometer 13 is experimentally set to be 0.22 mm, successfully transformed to the pulse of about 17 ps as the Fabry-Perot output. The product  $\Delta v \Delta \tau$  of the output is estimated as follows.

 $\Delta v \Delta \tau = 0.22 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{2} / (1.54 \times 10^{-6})^{2} \times 17 \times 10^{-12} = 0.47$  (3)

This value is very close to the result of the formula (1), indicating that the pulse of the transform limit is obtained. Originally, the pulse is the chirped one, and a slight chirp is present in principle even with the width of 0.22 mm. In order to completely compensate this chirp, an optical fiber having the normal dispersion for negative chirp compensation may be inserted between the Fabry-Perot interferometer 13 and the optical coupler 14. For example, if the chirp of 2 ps is present in the bandwidth of 0.2 nm, i.e., in a case of 10 ps/nm, this may be realized by setting the length of the optical fiber for permanent compensation to be 200 m by utilizing that the dispersion quantity of the fiber with the zero-dispersion wavelength shifted from 1.6 to 1.8 µm band is 50 ps/km/mm.

As described above, by inserting the Fabry-Perot interferometer 13, the pulse of the transform limit can be obtained. However, the transmission output will be degraded by about 5-10 dB if this state is left as it is. The causes of the degradation include the loss by limiting the spectral width firstly and the transmission loss of the Fabry-Perot interferometer 13 secondly. In the experiment, the free spectrum range of the Fabry-Perot interferometer 13 is set to be about 6 nm in the experiment. In other words, if the

free spectrum range is set to be  $\Delta\lambda$ , and L = 200 $\mu$ m, it is expressed as follows:

 $\Delta \lambda = C/2L \times (\lambda^2/C) = (1.54 \times 10^{-2})^2/2 \times 200 \times 10^{-6} = 6 \text{nm}$ (4)

Therefore, in the case of Distributed Feedback Laser (DFB), the amplitude of the single spectrum oscillation (including chirp) is about 2 nm at most, and the filter space of 6 nm is sufficient. In other words, no other filter elements are included. Regarding the bandwidth of the Fabry-Perot interferometer 13, finesse may be adjusted from 0.1 mm to about 1 mm by adequately setting the reflectance when constituting the Fabry-Perot interferometer 13.

As described above, the pulse train of the complete transform limit can be obtained though the pulse output is weak.

Next, the pulse train is optically amplified to the power level of the photosoliton pulse train. This is performed by the erbium fiber amplifier (by combining the optical coupler 14, the erbium excitation light source 15 and the erbium fiber 16 with each other). Here, the pulse peak power of the standard photosoliton of N=1 is defined as  $P_{N=1}$ , PN is expressed as follows:

 $P_{N=1} = 0.776 \times \lambda^3/\pi^2 n_2 C \times |D|/\tau^2 \times Aeff$  (5)

where,  $n_2$  denotes the non-linear refractive index,  $\lambda$ 

denotes the wavelength of the optical pulses,  $\tau$  denotes the full width half maximum of the optical pulses, |D| denotes the group velocity dispersion of the photosoliton transmission fiber 3, Aeff denotes the effective sectional area of the photosoliton transmission fiber 3, and C denotes the light velocity.

For the output of the Fabry-Perot interferometer 13, the peak power is about 1 mW. For the standard of the photosoliton transmission fiber 3 to transmit photosoliton, for example, the dispersion shift fiber of  $|D| = 3ps/km \cdot ne$  is used, and Aeff = 4 x  $10^{-7}$  cm<sup>2</sup> can be set. In the case of the pulse of the input  $\tau = 20$  ps, and taking into consideration that n of the silica fiber is  $n_2 = 3.2 \times 10^{-20}$ ,  $P_{m=1}$  is given as follows.

 $P_{N=1} = 0.776 \times (1.55 \times 10^{-3}) 3/(\pi)^2 \times 3.2 \times 10^{-20} \times 3 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-2}/(20 \times 10^{-13})^2 \times 4 \times 10^{-11} = 9.2 \text{ mW}$  (6)

In other words, with the above-described power, Sech type photosoliton of N=1 can be propagated through the long photosoliton transmission fiber 3.

Next, the required gain of the erbium fiber amplifier may be about 10 dB from the formula (6) and the condition of the input of 1 mW. In this case, as shown in Fig. 5, the gain of 20 dB or over is easily obtained in the erbium fiber of 3 to 100 m, and it is understood that this method is very

effective. Regarding the details of the amplification, refer to "Optical amplification by the optical fiber", By NAKAZAWA, Masataka, Kogaku Vol. 18, No. 6, p. 291 to p. 296.

The wavelength of the erbium excitation light source 15 includes 0.5  $\mu$ m, 0.6  $\mu$ m, 0.3  $\mu$ m, 0.98  $\mu$ m, and 1.48  $\mu$ m band. In Fig. 5, 1.48  $\mu$ m is obtained with the InCaAsP semiconductor laser as the excitation light source.

Here, noise due to the amplified spontaneous emission other than the signal light is eliminated by the optical filter 17 for eliminating amplified spontaneous emission. In addition, non-photosoliton elements for other noise are slightly generated due to losses in the photosoliton transmission fiber 3. However, photosoliton portions are completely transmitted and the non-photosoliton portions are completely absorbed by attaching the super-saturated absorber such as the InGaAs MQW semi-conductor to the filter 17 for eliminating amplified spontaneous emission, and photosoliton can be consistently transmitted. Fig. 6 shows how the photosoliton is transmitted. Fig. 6(a) and Fig. 6(b) show how noise is completely eliminated before and after passing the super-saturated absorber, respectively.

Thus-obtained pulses are propagated as photosoliton through the photosoliton transmission fiber 3, reproduced and relayed by the pre-emphasis method (Japanese Patent Application No. 1-68619, photosoliton generating system, by

KUBOTA, Hirokazu, NAKAZAWA Masataka, and SUZUKI Kazunobu), and finally information is taken out by the photo detector 4, completing the optical communication by photosoliton.

Next, a second embodiment of the present invention will be described. The second embodiment is a method for multiplexing the super-high repetitive photosoliton pulse train to the 2<sup>N-1</sup> times of the original pulse repetition of the semi-conductor laser 7 on the time axis by using a plurality of optical couplers of 1:1 coupling. Fig. 7 shows the configuration thereof. The semi-conductor laser 7 is pulse-driven by the electric signal which is sinusoidally modulated by the pulse signal generator 11 and the electric amplifier 6, and the spectral elements thereof are narrowbanded, and led to the 3 dB coupler group 18. By using a coupler of N-pole, multiplexing can be realized to 2<sup>N-1</sup> times on the time axis.

Here, the length of one of two arms of the 3 dB coupler connected for generating time delay and multiplexing pulses is changed. The difference of the length of the arms of the 3 dB coupler is set so that the time delay is T/2 (T = 2<sup>i</sup> (i = 1, 2, ... N-1). For example, a shift of 1cb may be provided to give the time delay of 50 ps. As described above, pulses can be easily multiplexed. However, in this case, the pulse peak intensity can be reduced to 1/2 by being passed through N-pieces of 3 dB couplers, and can be

compensated by the above-described erbium fiber amplifier. In the multiplexing by the method, the signal is turned ON-OFF by the super high-speed optical modulator 10. Super high-speed photosoliton communication can be realized thereby.

Next, Fig. 8 explains a third embodiment of the present invention. Similar to Fig. 7, in place of direct modulation of the semi-conductor laser 7, the absorption type optical modulator 10a using a LiNbO<sub>3</sub> photo modulator or a MQW semi-conductor is inserted between the Fabry-Perot interferometer 13 and the optical coupler 14, and photosoliton is turned ON-OFF thereby. This method is advantageous in that the semi-conductor laser 7 need not be directly modulated though the absorption type optical modulator 10a must be used.

#### [Advantages]

As described above, the photosoliton pulse of high output at the transform limit which has been impossible in a known method can be generated from a semi-conductor laser by using a narrow-band pass filter such as a Fabry-Perot interferometer and an erbium fiber amplifier, resulting in an advantage of extensive application to the communication using the light intensity modulation. In other words, any high-speed photo modulator by LiNbO<sub>3</sub> or MQW semi-conductor which has been essential for the known high-speed optical

communication becomes unnecessary, and the semi-conductor laser may be singly and directly modified at a high speed. Therefore, it is advantageous that the photosoliton transmission system becomes very simple.

If the pulse waveform is disturbed when the semiconductor laser is directly modulated by the pulse code, a
high-speed optical modulator may be inserted between a
narrow-band pass filter and an erbium fiber amplifier. In
this case, the semi-conductor laser is not directly modified,
there is a possibility that photosoliton transmission is
more consistent.

In addition, even in the super highly repetition such as 30-100 GHz, the photosoliton pulse at the transform limit can be realized so long as the semi-conductor laser can be directly modified in the frequency zone, and the present invention is very effective.

## 4. Brief Description of the Drawing

Fig. 1 explains a first embodiment of the present invention, Fig. 2 shows a circuit to drive a semi-conductor laser (7) and a waveform diagram to indicate the output of each component thereof, Fig. 3 shows the output waveform diagram of the semi-conductor laser (7), Fig. 4 shows the chirp characteristic of the semi-conductor laser (7), Fig. 5 shows the optical amplification characteristic of erbium

fibers, Fig. 6 explains a method for eliminating nonphotosoliton elements by using an over-saturated absorbing
body, Fig. 7 explains a second embodiment of the present
invention, Fig. 8 explains a third embodiment of the present
invention, Fig. 9 explains a method for generating
photosoliton by a color center laser (1), Fig. 10 explains
the waveform change of photosoliton generated by the
configuration shown in Fig. 9, Fig. 11 explains a short
pulse generating method by the sinusoidal modulation, Fig.
12 explains a short pulse generating method by a combgenerator, and Fig. 13 explains a pulse generating method by
an optical modulator.

- 1 ... color center laser,
- 2 ... coupling lens,
- 3 ... photosoliton transmission fiber
- 4 ... photo detector, 5 ... sinusoidal wave generator
- 6 ... electric amplifier, 7 ... semi-conductor laser,
- 8 ... comb-generator, 9 ... DC power source,
- 10 ... super high-speed optical modulator,
- 10a ... absorption type optical modulator,
- 11 ... pulse signal generator,
- 12 ... electric low-pass filter,
- 13 ... narrow-band optical filter (Fabry-Perot interferometer or the like),

- 14 ... optical coupler,
- 15 ... erbium excitation light source,
- 16 ... erbium fiber,
- 17 ... optical filter for eliminating amplified spontaneous emission
- 18 ... 3 dB coupler group

E	т	C		1
•		L7	_	1

- 11 PULSE SIGNAL GENERATOR
- 6 ELECTRIC AMPLIFIER
- 12 ELECTRIC FILTER
- 13 FABRY-PEROT INTERFEROMETER
- 14 OPTICAL COUPLER
- 16 ERBIUM FIBER
- 15 LIGHT SOURCE FOR ERBIUM FIBER EXCITATION
- 17 FILTER FOR ELIMINATING AMPLIFIED SPONTANEOUS EMISSION
- 4 PHOTO DETECTOR

- (A) P,
- (B) P2 (EXTRACTION OF FUNDAMENTAL WAVE ELEMENTS
- (C) P<sub>3</sub> AMPLIFICATION
- FIG. 3 OUTPUT OF SEMI-CONDUCTOR LASER
- (A) SPECTRUM
- (B) PULSE ACTUAL WAVEFORM
- (1) WAVELENGTH
- (2) TIME

#### FIG. 4 CHIRP CHARACTERISTIC OF SEMI-CONDUCTOR LASER

- (1) AMPLITUDE (PULSE)
- (2) TIME
- (3) CHIRPED TO THE LONG WAVELENGTH SIDE
- FIG. 5 OPTICAL AMPLIFICATION CHARACTERISTIC OF ERBIUM
  FIBER
- (1) (GAIN dB)
- (2) ABSORPTION EXCITATION POWER (MW)

FIG. 6

- (A) BEFORE PASSING SUPER-SATURATED ABSORBER
- (B) AFTER PASSING SUPER-SATURATED ABSORBER
- (1) PHOTOSOLITON
- (2) (NON-PHOTOSOLITON PORTION)

FIG. 7

- 18 3 dB COUPLER GROUP
- (1) TO BE COUPLED WITH 14 IN FIG. 1
- 10 SUPER HIGH-SPEED PHOTO-MODULATOR

#### 10a ABSORPTION TYPE PHOTO DETECTOR

FIG. 9

- 1 COLOR CENTER LASER
- 2 COUPLING LENS
- 3 PHOTOSOLITON TRANSMISSION FIBER
- 4 PHOTO DETECTOR

FIG. 10

- (A) OPTICAL FIBER INPUT OPTICAL PULSE
- (B)
- (C) N = 1 PHOTOSOLITON
- (D) HIGH ORDER PHOTOSOLITON
- (E)

FIG. 11

- 6 ELECTRIC AMPLIFIER
- 5 SINUSOIDAL WAVE GENERATOR
- 7 SEMI-CONDUCTOR LASER

8 COMB GENERATOR

- 9 DC CURRENT
- 10 SUPER HIGH-SPEED PHOTO MODULATOR

